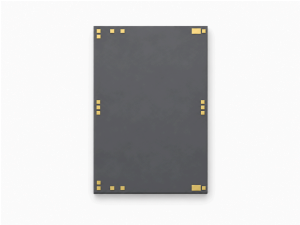
شريحة عارية لمضخم قدرة GaN MMIC بتردد 13750–15350 MHz



LCI-PA-13750-15350-PS48T شريحة عارية لمضخم قدرة GaN MMIC تغطي 13750–15350 MHz وتدعم التشغيل المستمر CW والنبضي.

النبضي: PSAT: 47 dBm (أدنى) / 48 dBm (نموذجي)؛ كسب القدرة: 19 dB (أدنى) / 20 dB (نموذجي)؛ PAE: 35 % (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 5.9 × 3.7.

خصائص RF

النبضي ;TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	f	13750	-	15350	MHz
قدرة الخرج المشبعة	Psat	47	48	-	dBm
كسب القدرة	Gp	19	20	-	dB
استواء كسب القدرة	ΔGp	-	±0.5	-	dB
كفاءة القدرة المضافة	PAE	-	35	-	%
نسبة VSWR للدخل	VSWR(in)	-	2	-	-

انحياز DC والتيارات

TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
جهد المصرف	Vd	24	28	32	V
جهد البوابة	Vg	-5	-2.9	-2.6	V
تيار سكون المصرف	Id	-	0.5	-	A
تيار المصرف الديناميكي	Idd	-	6.5	-	A
تيار البوابة الديناميكي	Igg	-	0.5	5	mA

القيم الحدية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى جهد بين المصرف والمصدر	Vd	-	-	32	V
أدنى انحياز للبوابة	Vg	-5	-	-	V
أقصى قدرة دخل	Pin	-	-	31	dBm
درجة حرارة التخزين	TSTG	-65	-	150	°C
أقصى درجة حرارة للقناة	Top	-	-	225	°C

أبعاد الشريحة

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الشريحة	3.7 × 5.9 × 0.1	mm

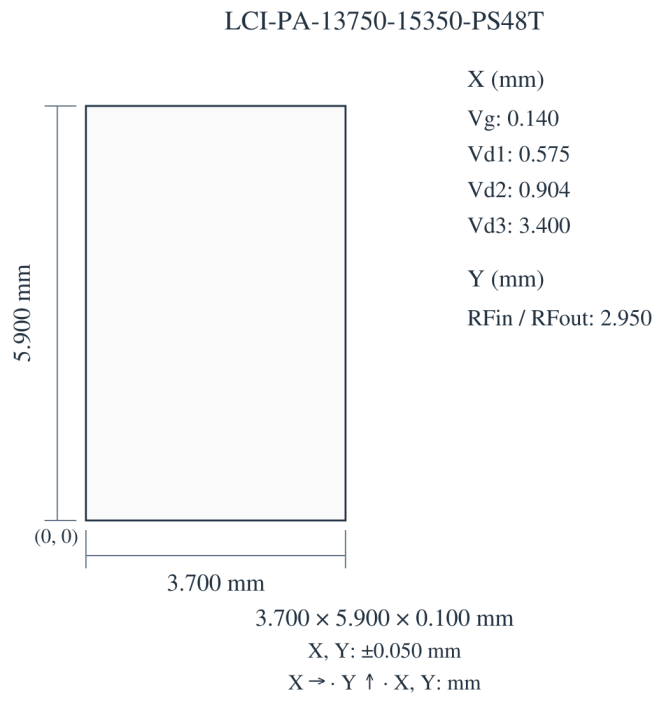
سجل الإصدار الحالي · 2026-11-12 · 1.7. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.6.

دمج الشريحة وتسلسل الانحياز

حجب DC المدمج: RFin / RFout. مسار DC إلى الأرضي: RFin → GND. توصيف بشروط مستقلة: Vd = +28 V; Id = 0.5 A; CW. طبّق انحياز البوابة قبل انحياز المصرف، وعند الإيقاف أزل انحياز المصرف أولاً. يلزم تغذية الجانبين؛ التغذية من جانب واحد ممنوعة.

مخطط الأبعاد الميكانيكية

رسم مرجعي للمحيط الخارجي والإحداثيات المبيّنة، بالأبعاد بوحدة mm. يقتصر استخدامه على الرجوع إلى الأبعاد ولا يحل محل رسم التصنيع أو الربط السلكي الكامل.

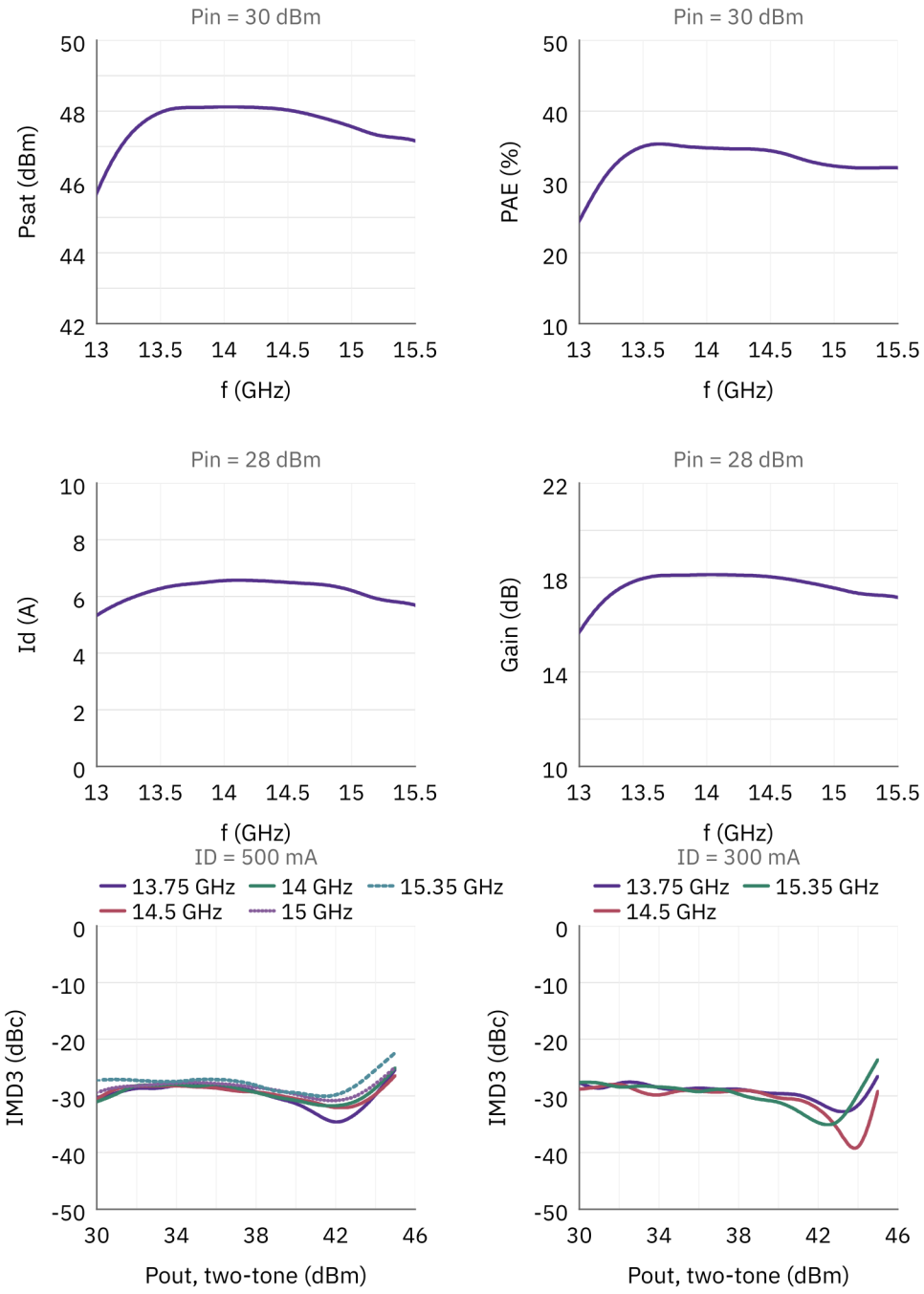


منحنيات الأداء

تُفسَّر كل منحنيات الأداء وفق ظروف التشغيل المبيّنة في الشكل المعني.

موجة مستمرة — (CW) قدرة الخرج المشبعة؛ كفاءة القدرة المضافة؛ تيار المصرف الديناميكي؛ كسب القدرة؛ IMD3.

القيم المقروءة تقريبية. ملاحظات الشكل: Id = 500 mA; Vd = +28 V; CW. Psat/PAE: Pin = 30 dBm. Id/Gain: Pin = 28 dBm. IMD3: Id = 500 mA / 300 mA.



ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.